

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2012-104532

(P2012-104532A)

(43) 公開日 平成24年5月31日(2012.5.31)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
<b>HO 1 L 21/301 (2006.01)</b>	HO 1 L 21/78 L	4E068
<b>B 2 3 K 26/00 (2006.01)</b>	HO 1 L 21/78 B	4M106
<b>B 2 3 K 26/18 (2006.01)</b>	B 2 3 K 26/00 M	
<b>HO 1 L 21/66 (2006.01)</b>	B 2 3 K 26/18 P	
	HO 1 L 21/66	

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 15 頁)

(21) 出願番号 特願2010-249430 (P2010-249430)  
 (22) 出願日 平成22年11月8日 (2010.11.8)

(71) 出願人 000134051  
 株式会社ディスコ  
 東京都大田区大森北二丁目13番11号  
 (74) 代理人 100121083  
 弁理士 青木 宏義  
 (74) 代理人 100138391  
 弁理士 天田 昌行  
 (74) 代理人 100132067  
 弁理士 岡田 喜雅  
 (74) 代理人 100137903  
 弁理士 菅野 亨  
 (74) 代理人 100150304  
 弁理士 溝口 勉

最終頁に続く

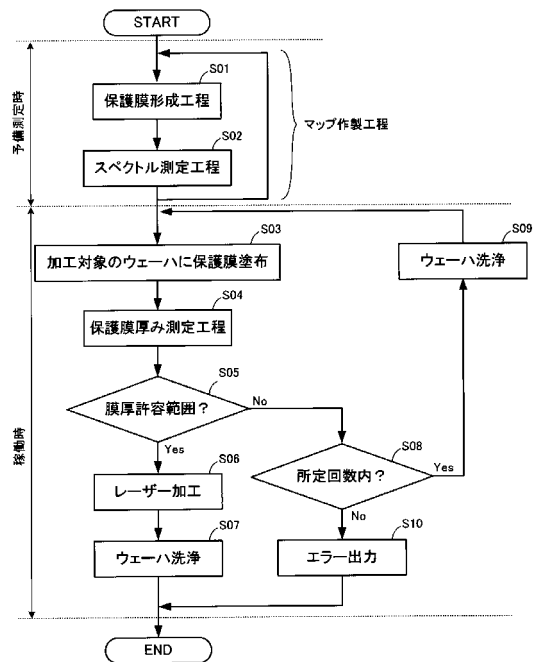
(54) 【発明の名称】 測定方法および測定装置

(57) 【要約】

【課題】ワーク表面に形成された保護膜の厚みを精度よく測定できる測定方法および測定装置を提供すること。

【解決手段】本発明の測定方法は、ウェーハWに光吸収剤を含む保護膜61を形成するステップと、保護膜61に測定光を照射し、測定光の吸収による保護膜61の発光を受光するステップと、事前に作製された保護膜61の厚みの変化に対する保護膜61の発光による光スペクトルの変化を示す測定データを参照して、保護膜61の発光強度から保護膜61の厚みを測定するステップとを有する構成とした。

【選択図】 図5



**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

ワークをレーザー加工する際に発生する加工屑からワークの表面を保護するために前記レーザーの波長の光を吸収する吸収剤を含んだ水溶性樹脂によって形成された保護膜の厚みを測定する測定方法であって、

前記吸収材を含んだ水溶性樹脂によってワーク表面に所定の厚みとなる様に前記保護膜を形成する保護膜形成工程と、

前記保護膜形成工程の後に、ワーク表面に形成された前記保護膜に前記吸収剤が吸収する波長の光を照射して、該光の吸収によって前記吸収剤が発光する光スペクトルを受光して測定するスペクトル測定工程と、

前記保護膜形成工程で形成する前記保護膜の厚みを変化させながら前記スペクトル測定工程を行うことで前記保護膜の厚み変化に対する前記光スペクトルの変化を表すマップを作製するマップ作製工程を含み、

ワークの表面に塗布された前記保護膜の厚みを測定する際は、

前記保護膜に前記吸収剤が吸収する波長の光を照射して前記光スペクトルを測定し、前記マップに基づいて前記保護膜の厚みを測定する保護膜厚み測定工程を実施することを特徴とする測定方法。

**【請求項 2】**

前記吸収剤が吸収する光の波長は少なくとも 250 nm 以上かつ 380 nm 以下、もしくは 460 nm 以上かつ 650 nm 以下のいずれかの波長を含むことを特徴とする請求項 1 に記載の測定方法。

**【請求項 3】**

ワークをレーザー加工する際に発生する加工屑からワークの表面を保護するために前記レーザーの波長の光を吸収する吸収剤を含んだ水溶性樹脂によって形成された保護膜の厚みを測定する測定装置であって、

前記吸収剤が吸収する波長の光をワーク表面に形成された保護膜に向けて照射する光照射部と、

前記吸収剤が前記光照射部からの光を吸収して発光する光スペクトルを受光する受光部と、

前記保護膜の厚み変化に対する前記光スペクトルの変化を表すマップを記憶する記憶手段と、

前記受光部で受光した光スペクトルと前記記憶手段で記憶した前記マップに基づいて前記保護膜の厚みを求める算出手段と、を有することを特徴とする測定装置。

**【発明の詳細な説明】****【技術分野】****【0001】**

本発明は、ワーク表面に形成された保護膜の厚みを測定する測定方法および測定装置に関する。

**【背景技術】****【0002】**

半導体ウェーハ等のワークをストリートに沿って分割する方法として、レーザー加工により分割する方法が知られている（例えば、特許文献 1 参照）。特許文献 1 のレーザー加工方法では、半導体ウェーハに対するレーザー光線の照射によって、照射領域に発生する熱エネルギーにより半導体ウェーハ上がストリートに沿って連続的に加工される。半導体ウェーハ上の照射領域には、熱エネルギーが集中してデブリ（加工屑）が発生する場合があります、このデブリが L S I のボンディングパッド等に付着して半導体チップの品質を低下させるという問題がある。

**【0003】**

この問題を解決するために、本件出願人は、半導体ウェーハ表面に水溶性の保護膜を形成し、保護膜を通して半導体ウェーハにレーザー光線を照射するレーザー加工方法を考案

10

20

30

40

50

した（例えば、特許文献2参照）。特許文献2のレーザー加工方法では、保護膜を通して半導体ウェーハが加工されるため、レーザー加工により飛散したデブリを保護膜に付着させることができる。そして、洗浄工程においてデブリが付着した保護膜が除去されることで、半導体ウェーハ表面へのデブリの付着を抑制して半導体チップの品質低下を防止する。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】特開平6-120334号公報

【特許文献2】特開2004-322168号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

レーザー加工により保護膜を通して半導体ウェーハを加工するためには、保護膜の厚みが一定であることが好ましい。すなわち、保護膜の厚みがレーザー加工結果に影響を与えており、保護膜が薄すぎると、半導体ウェーハをデブリから十分に保護できず、保護膜が厚すぎると、レーザー加工の妨げとなる。このため、レーザー加工前に半導体ウェーハ上の保護膜の厚みを精度よく測定する方法が求められていたが、従来の測定方法を行う測定装置は大掛かりかつ高コストであり、測定装置を加工装置の台数分用意したり、加工装置に組み込むことが難しいという問題があった。

【0006】

本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、従来の測定装置よりも簡素にワーク表面に形成された保護膜の厚みを精度よく測定できる測定方法および測定装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明の測定方法は、ワークをレーザー加工する際に発生する加工屑からワークの表面を保護するために前記レーザーの波長の光を吸収する吸収剤を含んだ水溶性樹脂によって形成された保護膜の厚みを測定する測定方法であって、前記吸収材を含んだ水溶性樹脂によってワーク表面に所定の厚みとなる様に前記保護膜を形成する保護膜形成工程と、前記保護膜形成工程の後に、ワーク表面に形成された前記保護膜に前記吸収剤が吸収する波長の光を照射して、該光の吸収によって前記吸収剤が発光する光スペクトルを受光して測定するスペクトル測定工程と、前記保護膜形成工程で形成する前記保護膜の厚みを変化させながら前記スペクトル測定工程を行うことで前記保護膜の厚み変化に対する前記光スペクトルの変化を表すマップを作製するマップ作製工程を含み、ワークの表面に塗布された前記保護膜の厚みを測定する際は、前記保護膜に前記吸収剤が吸収する波長の光を照射して前記光スペクトルを測定し、前記マップに基づいて前記保護膜の厚みを測定する保護膜厚み測定工程を実施することを特徴とする。

【0008】

本発明の測定装置は、ワークをレーザー加工する際に発生する加工屑からワークの表面を保護するために前記レーザーの波長の光を吸収する吸収剤を含んだ水溶性樹脂によって形成された保護膜の厚みを測定する測定装置であって、前記吸収剤が吸収する波長の光をワーク表面に形成された保護膜に向けて照射する光照射部と、前記吸収剤が前記光照射部からの光を吸収して発光する光スペクトルを受光する受光部と、前記保護膜の厚み変化に対する前記光スペクトルの変化を表すマップを記憶する記憶手段と、前記受光部で受光した光スペクトルと前記記憶手段で記憶した前記マップに基づいて前記保護膜の厚みを求める算出手段と、を有することを特徴とする。

【0009】

これらの構成によれば、保護膜が加工用レーザーの波長の光を吸収する吸収剤を含むため、吸収剤が吸収する波長の光の照射によって、保護膜の厚みの変化に対する光スペクトル

10

20

30

40

50

ルの変化を表すマップが作製される。このマップに基づいて、吸収剤が吸収する波長の光を照射して得られる光スペクトルから保護膜の厚みを精度よく測定できる。したがって、保護膜の厚みを一定に保った状態でレーザー加工することができ、ワークに対するデブリの付着を抑えてワークの品質低下を防止することができる。また、保護膜が光を吸収して発する光スペクトルを測定するため、ワークの種類に依らず同一のマップに基づいて保護膜を測定できる。

【0010】

また本発明は、上記測定方法において、前記吸収剤が吸収する光の波長は少なくとも250nm以上かつ380nm以下、もしくは460nm以上かつ650nm以下のいずれかの波長を含んでいる。

【発明の効果】

【0011】

本発明によれば、ワーク表面に形成された保護膜がレーザーの波長の光を吸収する吸収剤を含むことで、吸収剤が吸収する波長の光により保護膜の厚みを精度よく従来の測定装置よりも簡素に測定できる。

【図面の簡単な説明】

【0012】

【図1】本発明に係る測定方法の実施の形態を示す図であり、レーザー加工装置の斜視図である。

【図2】本発明に係る測定方法の実施の形態を示す図であり、レーザー加工装置の厚み測定処理の光学系の模式図である。

【図3】本発明に係る測定方法の実施の形態を示す図であり、発光強度と保護膜の種類および厚みとの関係の説明図である。

【図4】本発明に係る測定方法の実施の形態を示す図であり、厚み測定処理の説明図である。

【図5】本発明に係る測定方法の実施の形態を示す図であり、レーザー加工装置の動作のフローチャートである。

【図6】本発明に係る測定方法の変形例であり、レーザー加工装置の厚み測定処理の光学系の模式図である。

【発明を実施するための形態】

【0013】

図1を参照して、本発明に係る測定方法が適用されたレーザー加工装置について説明する。図1は、本発明の実施の形態に係るレーザー加工装置の斜視図である。なお、本発明の測定方法が適用されるレーザー加工装置は、図1に示す構成に限定されない。レーザー加工装置は、ワークに対してレーザー加工するものであれば、どのような構成を有していてもよい。また、本発明の測定方法は、図1に示すレーザー加工装置に適用される構成に限定されず、例えば、レーザー加工装置とは別体の膜厚測定専用の測定装置に適用される構成としてもよい。

【0014】

図1に示すように、レーザー加工装置1は、デブリの付着を防止する保護膜61(図2参照)をウェーハWに成膜すると共に、成膜後のウェーハWをレーザー加工するように構成されている。ウェーハWは、略円板状に形成されており、表面に格子状に配列された図示しないストリート(分割予定ライン)によって複数の領域に区画されている。ストリートによって区画された各領域には、IC、LSI等のデバイスが形成されている。また、ウェーハWは、貼着テープ63を介して環状フレーム62に支持され、カセット2内に収容された状態でレーザー加工装置1に搬入および搬出される。

【0015】

なお、本実施の形態においては、ワークとしてシリコンウェーハ(Si)、ガリウムヒソ(GaAs)、シリコンカーバイド(SiC)等のウェーハWを例に挙げて説明するが、この構成に限定されるものではない。例えば、チップ実装用としてウェーハWの裏面に

10

20

30

40

50

設けられる D A F (Die Attach Film) 等の粘着部材、半導体製品のパッケージ、セラミック、ガラス、サファイア ( $Al_2O_3$ ) 系の無機材料基板、液晶ディスプレイドライバー等の各種電気部品、ミクロンオーダーの加工位置精度が要求される各種加工材料をワークとしてもよい。

【 0 0 1 6 】

レーザー加工装置 1 は、直方体状のベッド部 3 と、ベッド部 3 の側方に設けられた搬入台 4 と、ベッド部 3 および搬入台 4 の後方で立設する立壁部 5 とを有している。搬入台 4 には、前方側にカセット 2 が載置される搬入搬出機構 1 1 が設けられ、後方側にウェーハ W 表面に保護膜 6 1 を形成する他、加工済みのウェーハ W を洗浄する保護膜形成機構 1 2 が設けられている。搬入搬出機構 1 1 および保護膜形成機構 1 2 の側方には、チャックテーブル 1 3 と、チャックテーブル 1 3 上のウェーハ W をレーザー加工するレーザー加工ユニット 1 4 と、レーザー加工前に、ウェーハ W の保護膜 6 1 の厚みを測定する厚み測定ユニット 1 5 とが設けられている。

10

【 0 0 1 7 】

搬入台 4 の上面には、搬入搬出機構 1 1 に載置されたカセット 2 に対してウェーハ W を出し入れするプッシュプル機構 1 6 が設けられている。搬入台 4 の上面には、プッシュプル機構 1 6 の駆動時に、ウェーハ W をスライド可能にガイドする一対のガイドレール 1 7 が設けられている。一対のガイドレール 1 7 と保護膜形成機構 1 2 との間には、ベッド部 3 および搬入台 4 でウェーハ W の受け渡しを行う搬送機構 1 8 が設けられている。

20

【 0 0 1 8 】

搬入搬出機構 1 1 は、カセット 2 を載置した状態で昇降されることにより、高さ方向におけるウェーハ W の出し入れ位置を調整している。プッシュプル機構 1 6 は、前後方向に移動可能に構成されており、ウェーハ W の周囲の環状フレーム 6 2 を挟持する挟持部 2 3 が設けられている。挟持部 2 3 は、上下方向に離間する一対の平行板を有し、図示しないエアアクチュエータにより駆動される。

【 0 0 1 9 】

保護膜形成機構 1 2 は、搬入台 4 の上面に形成された開口部 2 5 の中央に、ウェーハ W を保持する成膜用テーブル 2 6 を有している。成膜用テーブル 2 6 は、ウェーハ W を吸着保持する真空チャック式であり、周囲に環状フレーム 6 2 を保持する 4 つのクランプ部 2 7 が設けられている。このクランプ部 2 7 は、成膜用テーブル 2 6 の四方から延びる支持板に振り子状に支持されており、成膜用テーブル 2 6 の回転によって作用する遠心力により跳ね上げられてクランプする。

30

【 0 0 2 0 】

搬入台 4 の上面において成膜用テーブル 2 6 の近傍には、液状樹脂供給部 2 8 が設けられている。液状樹脂供給部 2 8 は、成膜用テーブル 2 6 上のウェーハ W の上面に液状樹脂を塗布する。ウェーハ W には、液状樹脂として、レーザーの波長の光を吸収する吸収剤を含むポリビニルアルコール (PVA) 等の水溶性樹脂が塗布される。この場合、紫外線波長域のレーザー光線 (例えば 355 nm の波長) を用いた加工時には、吸収剤として紫外線域の範囲 (例えば 250 nm 以上かつ 380 nm 以下の波長) の光を吸収する紫外線吸収剤が添加される。この場合、例えば、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、トリアジン系、ベンゾエート系のプラスチック添加剤が用いられる。また、可視光の波長域のレーザー光線 (例えば 533 nm の波長) を用いた加工時には、吸収剤として可視光の範囲 (例えば 460 nm 以上かつ 650 nm 以下の波長) の光を吸収する光吸収剤が添加される。この場合、例えば、水溶性染料化合物、水溶性色素化合物が用いられる。そして、保護膜形成機構 1 2 は、成膜用テーブル 2 6 を下降させて搬入台 4 の内部で高速回転させ、液状樹脂をウェーハ W 全面に広げることで成膜する。

40

【 0 0 2 1 】

また、保護膜形成機構 1 2 は、加工済みのウェーハ W から保護膜 6 1 を除去する洗浄機構としても機能する。搬入台 4 の内部には、図示しない洗浄ノズルが設けられている。保護膜形成機構 1 2 は、成膜用テーブル 2 6 に加工済みのウェーハ W が載置されると、開口

50

部 2 5 を介して成膜用テーブル 2 6 を搬入台 4 内に下降させる。そして、成膜用テーブル 2 6 は、搬入台 4 内において高速回転しつつ、洗浄水が噴射されることでウェーハ W から水溶性樹脂の保護膜 6 1 を洗浄除去する。その後、成膜用テーブル 2 6 は、高速回転された状態で洗浄水の噴射が停止され、ウェーハ W を乾燥する。

【 0 0 2 2 】

搬送機構 1 8 は、上下方向に延在する回動軸 3 1 と、回動軸 3 1 の上端に支持された伸縮アーム 3 2 と、伸縮アーム 3 2 の先端に設けられ、ウェーハ W を吸着保持する吸着保持部 3 3 とを有している。回動軸 3 1 は、上下動可能かつ回動可能に構成されており、伸縮アーム 3 2 は延在方向に伸縮可能に構成されている。吸着保持部 3 3 は、回動軸 3 1 の回動および伸縮アーム 3 2 の伸縮により水平面内における位置調整がされ、回動軸 3 1 の上下動により高さ方向における位置調整がされる。

10

【 0 0 2 3 】

そして、搬送機構 1 8 は、レーザー加工前においては、一对のガイドレール 1 7 上のウェーハ W をピックアップして、成膜用テーブル 2 6 に載置し、成膜用テーブル 2 6 上の成膜済みウェーハ W をピックアップして、チャックテーブル 1 3 に載置する。搬送機構 1 8 は、レーザー加工後においては、チャックテーブル 1 3 上の加工済みウェーハ W をピックアップして、成膜用テーブル 2 6 に載置し、成膜用テーブル 2 6 上の洗浄済みウェーハ W をピックアップして、一对のガイドレール 1 7 に戻す。

【 0 0 2 4 】

ベッド部 3 の上面には、チャックテーブル 1 3 を X 軸方向に加工送りすると共に、Y 軸方向に割出送りするチャックテーブル移動機構 3 5 が設けられている。チャックテーブル移動機構 3 5 は、ベッド部 3 上において X 軸方向に延在し、互いに平行な一对のガイドレール 3 6 と、一对のガイドレール 3 6 にスライド可能に設置されたモータ駆動の X 軸テーブル 3 7 とを有している。また、チャックテーブル移動機構 3 5 は、X 軸テーブル 3 7 上において Y 軸方向に延在し、互いに平行な一对のガイドレール 3 8 と、一对のガイドレール 3 8 にスライド可能に設置されたモータ駆動の Y 軸テーブル 3 9 とを有している。

20

【 0 0 2 5 】

Y 軸テーブル 3 9 の上部には、チャックテーブル 1 3 が設けられている。なお、X 軸テーブル 3 7 および Y 軸テーブル 3 9 の背面側には、それぞれ図示しないナット部が形成され、これらナット部にボールネジ 4 1、4 2 が螺合されている。そして、ボールネジ 4 1、4 2 の一端部には、それぞれ駆動モータ 4 3、4 4 が連結され、これら駆動モータ 4 3、4 4 によりボールネジ 4 1、4 2 が回転駆動される。

30

【 0 0 2 6 】

チャックテーブル 1 3 は、Y 軸テーブル 3 9 の上面において Z 軸回りに回転可能なテーブル 4 5 と、テーブル 4 5 の上部に設けられ、ウェーハ W を吸着保持するワーク保持部 4 6 とを有している。ワーク保持部 4 6 は、ウェーハ W を吸着保持する真空チャック式であり、上面にポラスセラミック材により吸着面が形成されている。吸着面は、負圧により貼着テープ 6 3 を介してウェーハ W を吸着する面であり、テーブル 4 5 の内部の配管を介して吸引源に接続されている。

【 0 0 2 7 】

ワーク保持部 4 6 の周囲には、テーブル 4 5 の四方から径方向外側に延びる一对の支持アームを介して 4 つのクランプ部 4 8 が設けられている。この 4 つのクランプ部 4 8 は、エアアクチュエータにより駆動し、ウェーハ W の周囲の環状フレーム 6 2 を四方から挟持固定する。

40

【 0 0 2 8 】

チャックテーブル 1 3 の後方に立設した立壁部 5 には、前面にアーム部 5 1 が突出して設けられている。アーム部 5 1 の先端側には、厚み測定ユニット 1 5 の測定ヘッド 5 2 と、レーザー加工ユニット 1 4 の加工ヘッド 5 3 と、アライメント用の撮像ヘッド 5 4 とが横並びに設けられている。測定ヘッド 5 2 からは、ウェーハ W の保護膜 6 1 の厚みを測定する測定光が照射される。加工ヘッド 5 3 からは、ウェーハ W を加工するレーザー光線が

50

照射される。撮像ヘッド 5 4 からは、撮像用の照明光が照射される。測定ヘッド 5 2、加工ヘッド 5 3、撮像ヘッド 5 4、アーム部 5 1、立壁部 5 内には、各種光学系が設けられている。

#### 【 0 0 2 9 】

測定光は、吸収剤を含む水溶性樹脂により形成されたウェーハ W の保護膜 6 1 によって吸収可能な波長に調整されている。例えば、紫外線波長域でレーザー加工される場合には、上記したように紫外線波長域の光を吸収可能な吸収剤が用いられるため、紫外線の範囲内に測定光の波長が合わせられる。また、可視光の波長域でレーザー加工される場合には、可視光を吸収可能な吸収剤が用いられるため、可視光の範囲内に測定光が合わせられる。厚み測定ユニット 1 5 は、測定光の吸収による保護膜 6 1 の蛍光発光を受光することで保護膜 6 1 の厚みを測定する。この場合、予めベッド部 3 内の制御部 1 9 に記憶された保護膜 6 1 の厚みの変化に対する光スペクトル（スペクトル分布）の変化を示すマップを参照して、保護膜 6 1 の厚みが測定される。そして、保護膜 6 1 の厚みが所定範囲内の場合には、レーザー加工ユニット 1 4 によってレーザー加工が開始され、保護膜 6 1 の厚みが所定範囲外の場合には、保護膜形成機構 1 2 において保護膜 6 1 が形成し直される。

10

#### 【 0 0 3 0 】

このように、レーザー加工ユニット 1 4 では、保護膜 6 1 の厚みが一定のウェーハ W のみがレーザー加工される。よって、レーザー加工時における保護膜 6 1 の厚みに起因する不具合が改善され、ウェーハ W に対するデブリの付着を抑えてウェーハ W の品質低下が防止される。このとき、保護膜 6 1 にレーザー波長の光を吸収する吸収剤が添加されているため、レーザー加工時にウェーハ W の加工と共に保護膜 6 1 も除去される。このため、ウェーハ W の熱分解物の蒸気等の圧力によって、保護膜 6 1 が剥がれることがなく、保護膜 6 1 の剥がれに起因するデブリの付着も防止される。

20

#### 【 0 0 3 1 】

厚み測定ユニット 1 5 による測定位置およびレーザー加工ユニット 1 4 による加工位置は、撮像ヘッド 5 4 によるアライメント処理により位置調整される。撮像ヘッド 5 4 は、CCD 等の撮像素子によりウェーハ W の表面を撮像して撮像画像をベッド部 3 内の制御部 1 9 へ出力する。制御部 1 9 は、予め記憶部に記憶された基準パターンと撮像画像に含まれるチップパターンとをマッチングさせることにより、アライメント処理を実施する。このアライメント処理により、レーザー加工時にはストリートに沿って精度よくレーザー加工される。

30

#### 【 0 0 3 2 】

制御部 1 9 は、レーザー加工装置 1 を統括制御するものであり、各種処理を実行するプロセッサ（算出手段）や、記憶部（記憶手段）等により構成されている。記憶部は、用途に応じて ROM (Read Only Memory)、RAM (Random Access Memory) 等の一つ又は複数の記憶媒体で構成される。記憶部には、厚み測定処理、アライメント処理、レーザー加工処理の各処理に用いられる制御プログラム等が記憶されている。また、記憶部には、厚み測定処理に用いるマップ、アライメント処理に用いる基準パターンが記憶されている。

40

#### 【 0 0 3 3 】

図 2 を参照して、レーザー加工装置の厚み測定処理の光学系について説明する。図 2 は、本発明の実施の形態に係るレーザー加工装置の厚み測定処理の光学系の模式図である。なお、レーザー加工処理のレーザー光学系、アライメント処理の読み取り光学系については、詳細な説明を省略するが、一般的な構成を備えたものであればどのような構成でもよい。

#### 【 0 0 3 4 】

図 2 に示すように、レーザー加工装置の光学系には、ウェーハ W の保護膜 6 1 の厚みを測定するための測定用光源 5 5 が設けられている。測定用光源 5 5 は、吸収剤に吸収される波長の測定光（本実施形態ではレーザー光線を用いる）を発振可能に設定されている。測定用光源 5 5 から出射された測定光の光路上には、ハーフミラー 5 6、ミラー 5 7、集

50

光レンズ 5 8 が配置されている。ハーフミラー 5 6 は測定用光源 5 5 から出射された測定光を透過してミラー 5 7 に導き、ウェーハ W の保護膜 6 1 からの発光を、ミラー 5 7 を介して受光部 5 9 に導くように構成されている。測定用光源 5 5、ハーフミラー 5 6、ミラー 5 7、集光レンズ 5 8 は、測定光を保護膜 6 1 に向けて照射する光照射部として機能する。

#### 【 0 0 3 5 】

受光部 5 9 は、図示しない受光素子等により、測定光の吸収による保護膜 6 1 の発光強度を電圧信号に変換して制御部 1 9 に出力する。制御部 1 9 では、レーザー加工装置 1 の加工ヘッド 5 3 の稼働前の予備測定時に電圧信号に基づいて光スペクトルのマップを作製する他、レーザー加工装置 1 の加工ヘッド 5 3 の稼働時に当該マップを用いて保護膜の厚みを測定する。集光レンズ 5 8 は、光軸方向に駆動可能に構成されており、測定光の集点を調整する。なお、集光レンズ 5 8 は、単レンズ、または組み合わせレンズで構成されている。また、マップの作成処理および測定処理の詳細については、後述する。

10

#### 【 0 0 3 6 】

測定用光源 5 5 から出射された測定光は、ハーフミラー 5 6 を透過してミラー 5 7 にて集光レンズ 5 8 に向けて反射され、集光レンズ 5 8 により集光されてウェーハ W の保護膜 6 1 に照射される。保護膜 6 1 は、測定光を吸収して発光する。そして、保護膜 6 1 の発光は、集光レンズ 5 8 を介してミラー 5 7 に入射され、ミラー 5 7 およびハーフミラー 5 6 で反射されて受光部 5 9 に入射される。なお、本実施の形態においては、厚み測定処理、レーザー加工処理、アライメント処理に用いられる光学系を個別に設ける構成としたが、共通の光学系で構成されてもよい。この場合、測定光として単位面積あたりの照射エネルギーを低く設定して紫外線波長域の加工用のレーザー光線を用いてもよい。

20

#### 【 0 0 3 7 】

ここで、図 3 を参照して、発光強度と保護膜の種類および厚みとの関係について説明する。図 3 は、本発明の実施の形態に係る発光強度と保護膜の種類および厚みとの関係の説明図である。なお、図 3 は、吸収剤として紫外線吸収剤を用いられる場合を示し、W 1 は A 保護膜（厚み 2  $\mu\text{m}$ ）が発する光スペクトル、W 2 は A 保護膜（厚み 0.8  $\mu\text{m}$ ）が発する光スペクトル、W 3 は B 保護膜（厚み 2  $\mu\text{m}$ ）が発する光スペクトル、W 4 は C 保護膜（厚み 2  $\mu\text{m}$ ）が発する光スペクトルをそれぞれ示す。また、A 保護膜は、B 保護膜よりも紫外線吸収剤の含有量が少なく、C 保護膜は紫外線吸収剤が含まれていない。

30

#### 【 0 0 3 8 】

上記した厚み測定ユニット 1 5 により、保護膜 6 1 に紫外線波長域の測定光を照射して発光強度を測定することで、保護膜 6 1 の任意の厚みに対する光スペクトルが得られる。さらに、保護膜 6 1 の種類および厚みを変化させることで、例えば、図 3 に示すような測定データが得られる。図 3 に示すように、A 保護膜（2.0  $\mu\text{m}$ ）が発する光スペクトル W 1 は、略 360 nm から略 560 nm の波長域で発光強度が山なりに変化する。B 保護膜（2.0  $\mu\text{m}$ ）が発する光スペクトル W 3 は、略 360 nm から略 560 nm 以上の波長域で発光強度が山なりに変化する。A 保護膜（2.0  $\mu\text{m}$ ）よりも発光強度のピーク値が高い。

40

#### 【 0 0 3 9 】

C 保護膜（2.0  $\mu\text{m}$ ）が発する光スペクトル W 4 は、保護膜 6 1 に紫外線吸収剤が含まれていないため、発光強度が 0 の状態で変化しない。このように、保護膜 6 1 の種類によって、スペクトルの分布が異なっている。A 保護膜（0.8  $\mu\text{m}$ ）の光スペクトル W 2 は、A 保護膜（2.0  $\mu\text{m}$ ）の光スペクトル W 1 よりも発光強度が低下している。このように、同一種類の保護膜 6 1 の場合には、所定の波長域において保護膜 6 1 の厚みに応じて発光強度が変化する。本発明では、この保護膜 6 1 の厚みの変化に対する発光強度の変化を利用して、ウェーハ W の保護膜 6 1 の厚みを測定する。

#### 【 0 0 4 0 】

図 4 を参照して、厚み測定処理について説明する。図 4 は、本発明の実施の形態に係る厚み測定処理の説明図である。なお、図 4 に示す分布は、一例に過ぎず、測定対象の膜厚

50

、閾値等を適宜変更することが可能である。また、図4の例では、保護膜の膜厚等による発光強度の違いが明確となる所定波長を特定するために、広波長域の発光強度の分布を示すマップを作製しているが、この構成に限定されるものではない。図4に示す広波長域の発光強度の分布を示すものではなく、予め定められた所定波長付近の測定結果のみでマップを作製してもよい。

#### 【0041】

図4(a)に示すように、レーザー加工装置1の加工ヘッド53の稼働前の予備測定時に、光スペクトルのマップが作製される。具体的には、保護膜61の厚み $T$ を $T_0\mu\text{m}$ から $T_4\mu\text{m}$ まで所定間隔で変化させたウェーハ $W$ を複数用意し、各ウェーハ $W$ に対して測定光を照射する。そして、保護膜61が発する光スペクトルを測定することで、保護膜61の厚みの変化に応じた光スペクトルデータが制御部19に入力される。制御部19は、光スペクトルデータからマップを作製して記憶する。この場合、各保護膜61の厚みの光スペクトルは、グラフ内両端における波長域において発光強度が0となり、所定波長 $L$ 付近において保護膜61の膜厚による発光強度の違いが明確となるので、測定光の波長としては $L$ 付近がより好ましいことが分かる。

10

#### 【0042】

レーザー加工装置1の加工ヘッド53の稼働時の厚み測定処理には、このように作製された光スペクトルのマップに基づいて、ウェーハ $W$ の保護膜61の厚みが測定される。例えば、図4(b)に示すように、光スペクトルのマップに発光強度の閾値 $t_0$ から $t_5$ を設定し、測定光が照射されることで保護膜61が発する光スペクトルの所定波長 $L$ 付近の発光強度と閾値 $t$ とを比較することで保護膜61の厚みが測定される。図4の例では、保護膜61の厚みの測定値は、閾値 $t_0$ より大きく閾値 $t_1$ 以下の発光強度で $T_0\mu\text{m}$ 、閾値 $t_1$ より大きく閾値 $t_2$ 以下の発光強度で $T_1\mu\text{m}$ 、閾値 $t_2$ より大きく閾値 $t_3$ 以下の発光強度で $T_2\mu\text{m}$ 、閾値 $t_3$ より大きく閾値 $t_4$ 以下の発光強度で $T_3\mu\text{m}$ 、閾値 $t_4$ より大きく閾値 $t_5$ 以下の発光強度で $T_4\mu\text{m}$ となる。また、保護膜61の厚みの測定値は、閾値 $t_0$ 以下の発光強度で $T_0\mu\text{m}$ 以下、閾値 $t_5$ 以上の発光強度で $T_4\mu\text{m}$ 以上となる。

20

#### 【0043】

なお、本実施の形態においては、光スペクトルの所定波長 $L$ 付近の発光強度により、保護膜61の厚みが測定される構成としたが、この構成に限定されるものではない。保護膜61の厚みは、光スペクトルの複数部分または全体により測定される構成としてもよい。

30

#### 【0044】

ここで、図5を参照してレーザー加工装置の動作について説明する。図5は、本発明の実施の形態に係るレーザー加工装置の動作のフローチャートである。レーザー加工装置1の加工ヘッド53の稼働前には、予備測定が行われて光スペクトルのマップが作製される。ここでは、搬送機構18により保護膜61が形成されていないマップ作成用のウェーハ $W$ が保護膜形成機構12に搬送され、ウェーハ $W$ 表面に所定の厚みとなるように保護膜61が形成される(保護膜形成工程:ステップS01)。尚、保護膜形成工程では従来の膜厚測定装置を使用して保護膜61が所定の厚みであることの確認を行う。次に、搬送機構18によりウェーハ $W$ がチャックテーブル13に搬送され、吸収剤に吸収される波長の測定光が保護膜61に照射されることで、保護膜61の任意の厚みに対する光スペクトルが測定される(スペクトル測定工程:ステップS02)。そして、保護膜形成工程でウェーハ $W$ に形成する保護膜61の厚みを変化させながらスペクトル測定工程を必要回数繰り返すことで、複数の厚みの保護膜61が発する光スペクトルが測定される。測定結果は、制御部19に入力されて保護膜の厚みの変化に対する光スペクトルの変化を表すマップが作製される(マップ作製工程)。そして、マップ作製工程が終了することで予備測定が終了する。尚、保護膜61の測定位置は、撮像ヘッド54によるアライメント処理により調整されている。

40

#### 【0045】

次に、レーザー加工装置の加工ヘッド53が稼働されると、プッシュプル機構16によりカセット2内から加工対象のウェーハ $W$ が一对のガイドレール17上に引き出され、搬

50

送機構 18 によりウェーハ W が保護膜形成機構 12 の成膜用テーブル 26 に搬送される。保護膜形成機構 12 において加工対象のウェーハ W 表面に所定の厚みとなるように保護膜 61 が形成される (ステップ S03)。ここでは、成膜用テーブル 26 上のウェーハ W に対し液状樹脂供給部 28 から液状樹脂が塗布される。そして、成膜用テーブル 26 が搬入台 4 内部で高速回転されることで、液状樹脂によりウェーハ W 全面が成膜される。

【0046】

次に、搬送機構 18 によりウェーハ W がチャックテーブル 13 に搬送され、チャックテーブル 13 により測定ヘッド 52 の下方に位置付けられる。測定ヘッド 52 の下方にウェーハ W が位置付けられると、ウェーハ W の保護膜 61 の厚みが測定される (保護膜厚み測定工程: ステップ S04)。ここでは、撮像ヘッド 54 によってアライメント処理が行われて、測定ヘッド 52 の測定位置が保護膜 61 上の任意の位置に調整される。測定ヘッド 52 により保護膜 61 に測定光が照射され、保護膜 61 の吸収剤による測定光の吸収によって発せられる光スペクトルの所定波長における発光強度が検出される。そして、制御部 19 において光スペクトルのマップに基づいて保護膜 61 の厚みが測定される。

【0047】

次に、制御部 19 において保護膜 61 の厚みが所定範囲内か否かが判定される (ステップ S05)。ここでは、例えば、保護膜厚み測定工程において測定された保護膜 61 の厚みとマップ作製工程において予め定められた判定用の上限閾値と下限閾値とが比較される。そして、保護膜 61 の厚みが下限閾値以上かつ上限閾値以下の場合に、適切な厚みの保護膜 61 として所定範囲内と判定される。保護膜 61 の厚みが下限閾値より小さい場合または上限閾値より大きい場合に、厚過ぎまたは薄過ぎの保護膜 61 として所定範囲外と判定される。なお、ステップ S05 の判定処理は、保護膜 61 上の数か所 (例えば、5箇所) で行われる。また、判定処理は、保護膜 61 の厚みの異常を特定可能であればよく、例えば、数か所の厚みのバラツキから判定してもよい。

【0048】

保護膜 61 の厚みが所定範囲内と判定されると (ステップ S05: Yes)、レーザー加工が開始される (ステップ S06)。ここでは、加工ヘッド 53 の射出口がウェーハ W のストリートに位置合わせされ、ストリートに沿ってレーザー光線が照射される。この場合、ウェーハ W の保護膜 61 が適切な厚みに形成されているため、保護膜 61 の厚みに起因した不具合が改善され、ウェーハ W に対するデブリの付着を抑えてウェーハ W の品質低下が防止される。また、保護膜 61 にはレーザー光線を吸収する吸収剤が含まれるため、レーザー光線により保護膜 61 が除去されつつウェーハ W がレーザー加工される。これにより、保護膜 61 の剥がれに起因するデブリの付着も防止される。

【0049】

次に、ウェーハ W の全てのストリートが加工されると、搬送機構 18 により加工済みのウェーハ W がチャックテーブル 13 から保護膜形成機構 12 の成膜用テーブル 26 に搬送される。本実施形態では水溶性樹脂を保護膜 61 として使用しているので、保護膜形成機構 12 において加工済みのウェーハ W から保護膜が洗浄除去される (ステップ S07)。ここでは、搬入台 4 内部で洗浄水が噴射されながら、成膜用テーブル 26 が高速回転されることで、ウェーハ W 表面から保護膜 61 と共にデブリが洗い流される。そして、搬送機構 18 により洗浄済みのウェーハ W が成膜用テーブル 26 から一対のガイドレール 17 に搬送され、プッシュプル機構 16 によりウェーハ W がカセット 2 に収容される。

【0050】

一方、保護膜 61 の厚みが所定範囲外と判定されると (ステップ S05: No)、保護膜厚み測定工程におけるウェーハ W に対する保護膜 61 の形成回数が所定回数 n 以下か否かが判定される (ステップ S08)。保護膜 61 の形成回数が所定回数 n 以下と判定された場合 (ステップ S08: Yes)、保護膜形成機構 12 に搬送されて、ステップ S07 と同様な洗浄処理によりウェーハ W から保護膜 61 が洗い流され (ステップ S09)、ステップ S03 に戻って保護膜 61 が形成し直される。また、保護膜 61 の形成回数が所定回数 n より多いと判定された場合 (ステップ S08: No)、制御部 19 によりエラーが

10

20

30

40

50

出力されてレーザー加工装置 1 が停止される (ステップ S 1 0)。なお、保護膜 6 1 の形成回数は、ステップ S 0 3 の保護膜形成処理時にカウントされるが、ステップ S 0 4 の保護膜 6 1 の厚み測定時およびステップ S 0 5 の判定処理時にカウントされる構成としてもよい。また、レーザー加工装置 1 は、複数枚ウェーハを加工する場合には、稼働時の処理 (ステップ S 0 3 ~ ステップ S 1 0) を枚数分繰り返す。

#### 【 0 0 5 1 】

以上のように、本実施の形態に係る測定方法によれば、保護膜 6 1 の厚みの変化に対する光スペクトルの変化を表すマップに基づいて、保護膜 6 1 に吸収剤が吸収する測定光を照射して得られる発光強度から保護膜 6 1 の厚みを精度よく従来の測定装置よりも簡素に測定できる。したがって、測定装置を加工装置の台数分用意したり、加工装置に組み込むことが容易となり、保護膜 6 1 の厚みを一定に保った状態でレーザー加工することができ、ウェーハ W に対するデブリの付着を抑えてウェーハ W の品質低下を防止することができる。また、保護膜 6 1 が測定光を吸収して発光するため、ウェーハ W の種類に依らず同一のマップに基づいて保護膜 6 1 を測定できる。

10

#### 【 0 0 5 2 】

なお、光学系として、例えば、図 6 に示すような射光式の光学系を用いてもよい。なお、図 6 は、可視光でレーザー加工される場合に用いられる厚み測定用の光学系を示すが、紫外光でレーザー加工される場合に用いられる厚み測定用の光学系に適用することも可能である。図 6 に示すように、この光学系の照射系側には、ウェーハ W の保護膜 6 1 の厚みを測定するための測定用光源として白色光源 6 5 が設けられている。白色光源 6 5 は、保護膜 6 1 表面に対して斜めに照射するように構成されており、白色光源 6 5 から出射された光吸収剤が吸収する波長の光を含む測定光の光路上には、測定光の焦点を調整する集光レンズ 6 6 が配置されている。白色光源 6 5 及び集光レンズ 6 6 は、測定光を保護膜 6 1 に向けて照射する光照射部として機能する。

20

#### 【 0 0 5 3 】

この光学系の受光系側には、測定光を吸収した保護膜 6 1 の吸収剤からの発光を受光して発光強度を測定する受光部 6 9 が設けられている。保護膜 6 1 から受光部 6 9 に向かう光の光路上には、任意波長の光以外を遮断するバンドパスフィルタ 6 7、バンドパスフィルタ 6 7 を通った光を受光部 6 9 の受光面に集光する集光レンズ 6 8 が配置されている。なお、集光レンズ 6 6、6 8 は、単レンズ、または組み合わせレンズで構成されている。

30

#### 【 0 0 5 4 】

白色光源 6 5 から出射された測定光は、集光レンズ 6 6 により集光されてウェーハ W 表面に対して斜めに照射される。保護膜 6 1 は、吸収剤により測定光を吸収して、測定光の吸収によって発光する。そして、ウェーハ W からの光は、バンドパスフィルタ 6 7、集光レンズ 6 8 を介して受光部 6 9 に入射される。なお、バンドパスフィルタ 6 7 の代わりに分光器により保護膜 6 1 からの光を分光して、任意波長の光を取得する構成としてもよい。

#### 【 0 0 5 5 】

また、上記した実施の形態においては、保護膜の厚みと光スペクトルとの関係を示す測定データとして、マップ形式のデータが用いられたが、この構成に限定されるものではない。測定データは、保護膜の厚みと光スペクトルとの関係を示すデータであればよく、例えば、保護膜の厚みの変化に対する保護膜の発光による光スペクトルの変化を示すテーブル形式のデータでもよい。

40

#### 【 0 0 5 6 】

また、上記した実施の形態においては、保護膜が吸収剤を含む水溶性樹脂により形成されたが、この構成に限定されるものではない。保護膜は、吸収剤を含めば、水溶性樹脂以外の樹脂材料により形成されてもよい。

#### 【 0 0 5 7 】

また、今回開示された実施の形態は、全ての点で例示であってこの実施の形態に制限されるものではない。本発明の範囲は、上記した実施の形態のみの説明ではなくて特許請求

50

の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。

【産業上の利用可能性】

【0058】

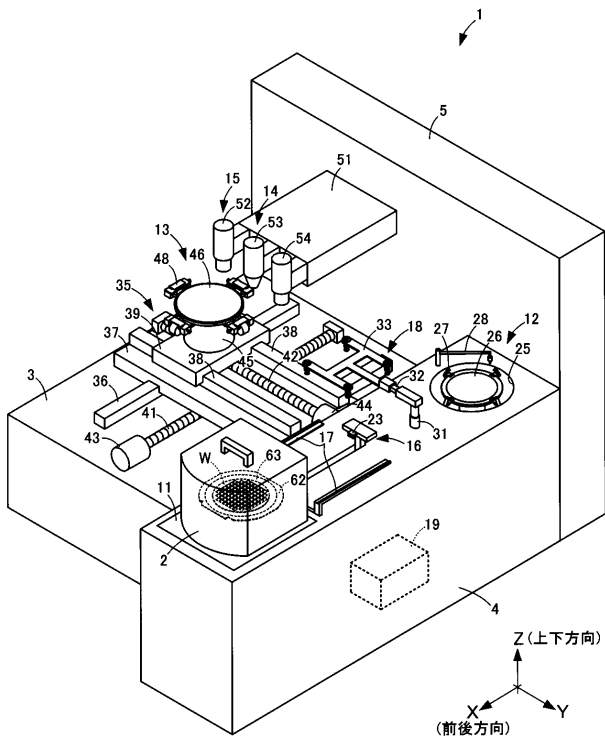
以上説明したように、本発明は、吸収剤が吸収する波長の光によりワークの保護膜の厚みを精度よく測定できるという効果を有し、特に、レーザー加工によりワークを分割するレーザー加工装置に適用される測定方法および測定装置に有用である。

【符号の説明】

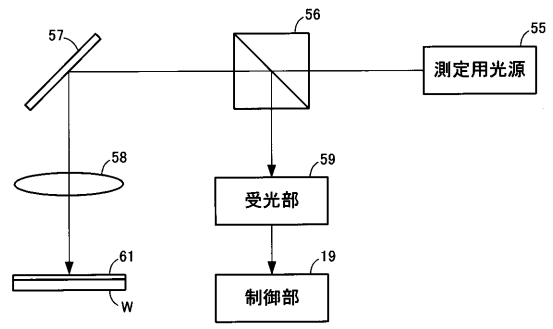
【0059】

1	レーザー加工装置（測定装置）	10
1 1	搬入搬出機構	
1 2	保護膜形成機構	
1 3	チャックテーブル	
1 4	レーザー加工ユニット	
1 5	厚み測定ユニット	
1 6	プッシュプル機構	
1 8	搬送機構	
1 9	制御部（記憶手段、算出手段）	
2 8	液状樹脂供給部	
5 2	測定ヘッド	20
5 3	加工ヘッド	
5 4	撮像ヘッド	
5 5	測定用光源（光照射部）	
5 6	ハーフミラー（光照射部）	
5 7	ミラー（光照射部）	
5 8、6 6	集光レンズ（光照射部）	
5 9	受光部	
6 1	保護膜	
6 5	白色光源（光照射部）	
W	ウェーハ（ワーク）	30

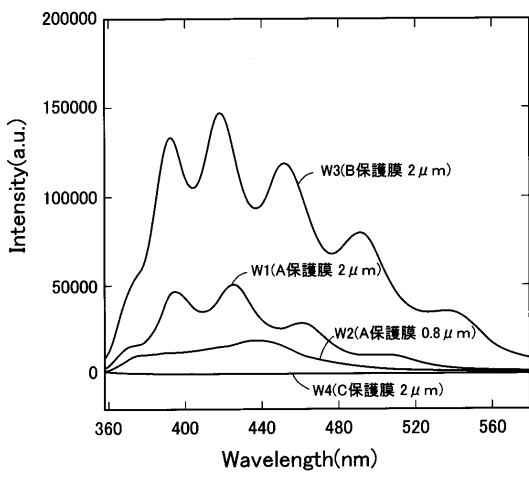
【 図 1 】



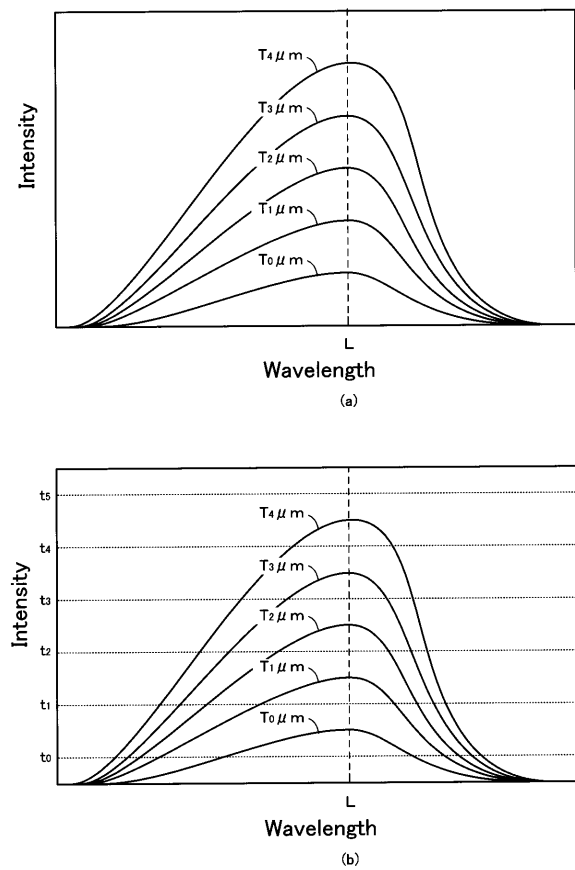
【 図 2 】



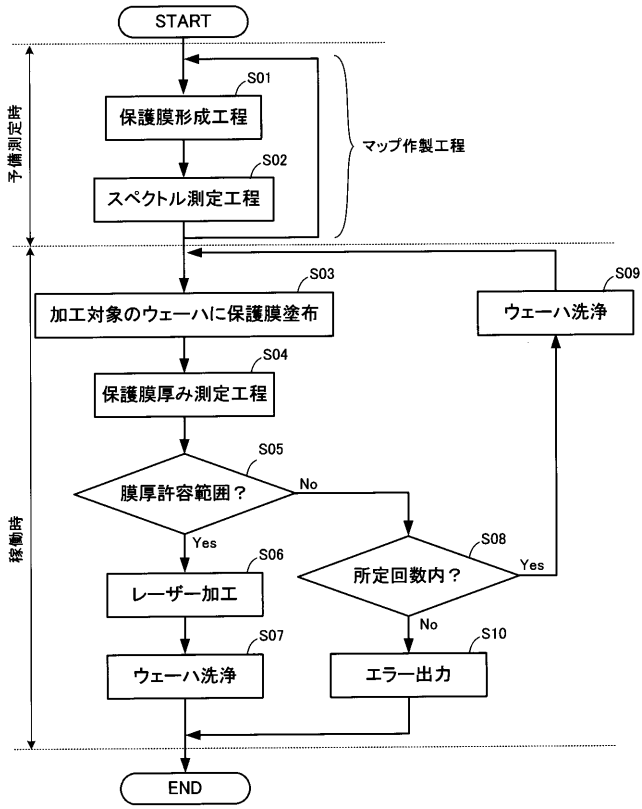
【 図 3 】



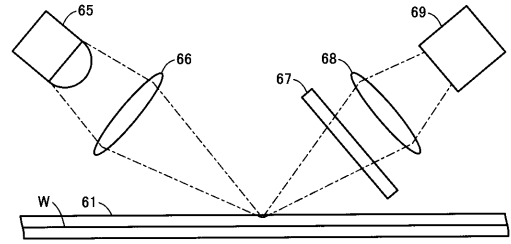
【 図 4 】



【 図 5 】



【 図 6 】



---

フロントページの続き

- (72)発明者 北原 信康  
東京都大田区大森北二丁目13番11号 株式会社ディスコ内
- (72)発明者 高橋 邦充  
東京都大田区大森北二丁目13番11号 株式会社ディスコ内
- (72)発明者 大浦 幸伸  
東京都大田区大森北二丁目13番11号 株式会社ディスコ内
- Fターム(参考) 4E068 CC01 CF00 DA10  
4M106 AA01 AA12 BA05 CA48 DH12 DH32 DJ20